# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-148190

(43) Date of publication of application: 24.06.1991

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

H04B 10/12

(21)Application number : 01-286285

(71)Applicant: NEC ENG LTD

(22)Date of filing:

02.11.1989

(72)Inventor: ARAI YASUMICHI

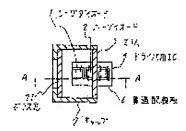
**AIKAWA TOSHIO** 

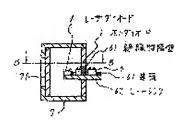
## (54) TRANSMISSION PACKAGE OF SEMICONDUCTOR LASER

## (57)Abstract:

PURPOSE: To reduce a parasitic inductance of a laser diode and an IC for driver and to enable rapid modulation by arranging a through-wiring plate on a stem and by mounting and wiring the laser diode, a photodiode and the IC for driver on the through-wiring board.

CONSTITUTION: A through-hole for part mount is provided to a substrate 61; and a wiring pattern for each signal between a laser diode 1 and an IC 5 for power source and driver and a wiring pattern for output of a photodiode 2 are provided thereon. A metallic heat sink 62 is attached at right angles to a stem 3 to fix and mount the laser diode 1, the photodiode 2 and the IC 5 for driver. A through-wiring board 6 is attached through a





wall side of a container, which consists of the heat sink 62, the substrate 61 and an insulator partition wall 63 provided between the photodiode 2 on an upper side of the substrate 61 and the IC 5 for driver. Thereby, it is possible to reduce a parasitic inductance between the laser diode 1 and the IC 5 for driver and to prevent development of waveform distortion during rapid modulation.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @公開特許公報(A)

平3-148190

இInt. Cl. 5

識別記号

庁內整理番号

@公開 平成3年(1991)6月24日

H 01 S 3/18 H 04 B 10/12

6940-5F

8523-5K H 04 B 9/00

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

98%明の名称

半導体レーザ送信パツケージ

负符 度 平1-286285

類 平1(1989)11月2日

井 @斧 明 習

廐

東京都港区西新橋3丁目20番4号 日本電気エンジニアリ

ング株式会社内

個発 畊 敏 夫

東京都港区西新港3丁目20番4号 日本電気エンジニアリ

ング株式会社内

願 人 日本電気エンジニアリ 砂出

ング株式会社 弁理士 内 原 個代 瑝 人

東京都港区西新橋3丁目20番4号

1. 発明の名称 **半導体レーザ遊館パッケージ** 

#### 2. 特許謝求の範囲

光学的に結合されたレーザダイオードとホトダ イオードとな透明な窓を有する容器内に気密劃入 しドライバー周I C と接続して使用する半導体 レーザ送信パッケージにおいて、前記レーザダイ オード,ホトダイオード及びドライバー用ICを 一面上に翻定する金属製のヒートシンクと、この ヒートシンタの都昂指載面上に設けられ前記レー ザダイオード、ホトダイオード及びドライバー用 ICが挿入可能な貫通孔を擦え表面に配線パター ンを有する熱板と、この基板の上面の前記ホトダ イオードとドライバー用ICとの間に取けられた 絶転物隔壁とから成る貫通配線板を前記容器の壁 面を貫通して取り付けたことを特徴とする半導体 レーザ送信パッケージ。

3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

**岑莞明は、光ファイバケーブル通信に**用いられ る芋蓴体レーザ遊信パッケージに関し、荷にその 実養辨消に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来この雌の半導体レーザ送信パッケージは、 ドライメ用ICとの鐘鏡に第3回に示すように リード蘇とプリント配鉄板を用いていた。第3回 において、レーザダイオード1とこれと光学的に 結合した帰還制御用のホトダイオード2は、金異 製のステム3aにハンダ合金などで墜著した後ス テム3aに気密保持された複数のリード線31と サイヤボンディングにより配線され、リード線31 . とプリント配線版イを介してドライバ用IC5a 及び電源と電気的接続を行っていた。

(発明が解決しようとする課題)

上述した健果の半導体レーザ器値パッケージは、 リード線とプリント配線板を介してレーザダイ オードとドライバ用IOを電気的に顕鋭している

**--** 1 --

特期平 3-148190(2)

ためレーザダイオードとドライバ用IC間の寄生 インダクタンスにより、高速変調時に波形歪が発 生するという欠点がある。

### [課題を解説するための手数]

本発明の半導体レーザメッケージは、光学的に 結合されたレーザダイオードとホトダイオードと を渡明か窓を有する容器内に気密封入しドライ バー用ICと接続して使用する半導体レーザ遊信 パッケージにおいて、前記レーザダイオード。ホ トダイネード及びドライバー用ICを一面上に クの 本ト がイオード及びドライバー用ICが手入 可能な大変面上に置けられ前記レーザダイオード でする金属製面上に置けられ前記レーディイネード でする金属製面上に置けられ前記レーディイスード でする金属製面上に置いて、一角ICが がある大変面に配額パターンを有する 基板と、この基板の上の間に設けられた絶縁物隔 という付けて標成されている。

#### (実施例)

次に、水発明について図面を参照して説明する。 - 8 元、

ている.

以上のようだ、ステュ3を貫通するように設けた賞通配級板6に半導幹部品を搭載した後、ガラ ス窓71を有するキャップ7をステム3に接合し、 レーザダイオード1,ホトダイオード2を気密封 止して半導体レーザ送径パッケージが完成する。 (発別の効果)

以上説明したように本発明は、ステムに質強配 線液を配置し、質理配線版上にレーザダイオー ド、ホトダイオード、ドライバ用ICを揺骸配線 することで、錠米のリード線とブリント認線板が 不要となり、レーザグイオードとドライバ用 C の寄生インダクタンスを低減することができる とから、高速変調可能な単準体レーザ送信 ステ かの実現が関れる。又、黄連配線版を2 寛発 たしてレーザダイオードとドライバ伝統を2 寛発 施をヒートシンクを介してステムに伝統でいる ため、ステムにベルチェクーラを配置すれば、 レーザダイオード、ドライバ周ICの程度マント ロールが容易にできるという効果がある。

第1億および第2回は本発明の一製造例の篠斷 面図および機断面図である。質道配除板 6 は、基 収61, ヒートシンク52, 絶縁物隔壁る3で襟 **並されている。基板 6 1 には、部最搭載用の貫通** 名があり、上面にレーザダイオード1の電源用お よびドライバ用IC5との間の各信号用の配線バ ターンと、ホトダイオード2の出力用配線パター ンが設けてある。なお、それぞれの配盤パターン と各搭載部晶とは、ワイヤーポンディングで接続 されている。ヒートシンク62は放熱鍵を考慮し て飼合金などで作業したもので、ステム3に直角 に取り付けられレーザダイオード1,ホトダイ オード2,ドライバ用IO5をハンダ合金などで **脳岸搭載すると共にレーザダイオードのアノード 端子を兼ねている。基板81の下面はメタライズ** 処理されており、ヒートシンク62にろう付けな どで絞合されている。絶縁動隔離83は、セラミッ クで作業したもので基板61の回路面に発成して 接合されている。ステム3は金属で作製したもの で貫通配線板もの取り付けはあう付けにより行っ。

-- 4 -

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図および第2 図は、本発明の辛華体レーザ 送録パッケージの一実施例を示す縦断嗣図および 核断函図、第3 面は健来の半導体レーザ送館パッ ケージの一側を示す縦断面図である。

1……レーザダイオード、2……ホトダイオード、3……ステム、31……リード線、4……ブリント配線板、5,52……ドライバ用IC、6……黄亜配線板、81……蒸板、62……ヒートシンク、63……捻線物隔線、7……キャップ、11……ガラス窓。

代華人 介展士 内 取 晉

— B <del>-</del>

